



DHBW-MaEp EL1 Klausur 2018/12 R.Bayer MUSTERLÖSUNG r1.2.0

Klausur 2018/12 r120

DHBW Mannheim-Eppelheim · TMT17AM2
Elektronik 1 (EL1) · Klausur 2018/12 · BayerMatrikel-Nr.: _____
Blatt 1 / 9Aufgabenblätter inkl. Deckblatt **9** Anzahl Lösungsbogen _____DHBW Mannheim-Eppelheim
Elektronik 1 (EL1)
TMT17AM2

Rev. 1.2.0

Klausur 2018/12

Dozent Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer Datum 07.12.2018

Matrikelnummer auf jedem Blatt/Bogen (Aufgaben und Lösungen) in der Kopfzeile eintragen

Studienjahrgang TMT17AM2

Hilfsmittel Taschenrechner, Formelsammlung 1 Blatt Zeit 60 min

Bewertung Punktzahl 100% Erreichte Punktzahl _____

Datum, Signum _____ Ergebnis _____

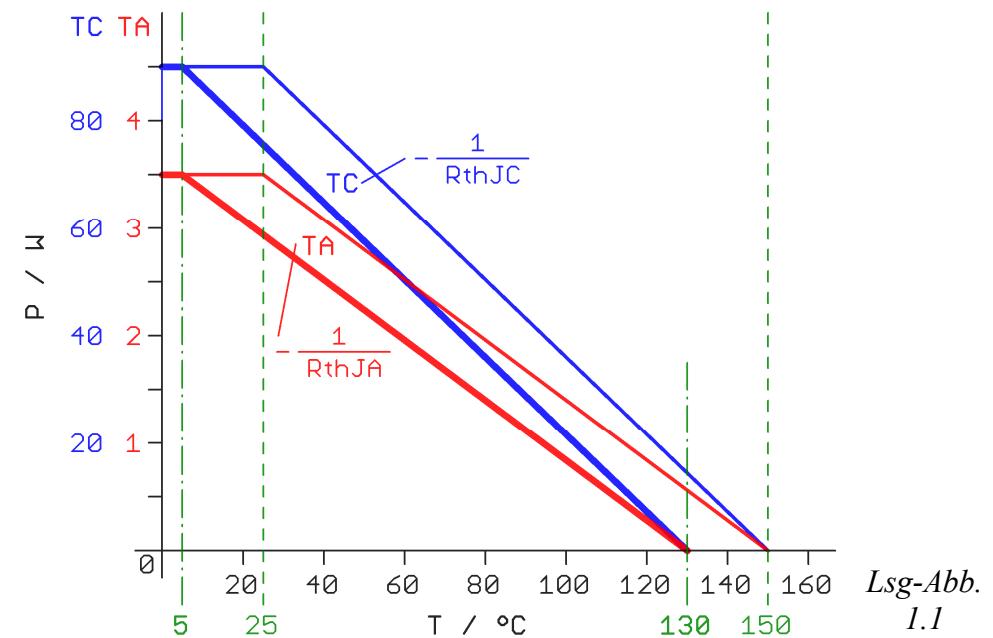
Aufg.	Thema	Blatt	a)	b)	c)	d)	e)	f)	Σ
1	Leistung: Derating, Kühlung	2-3	4	2	2	4	4	6	22
2	Z-Diode	4-5	2	6	4	10			22
3	Diode: Anwendung	6	8						8
4	BJT als Schalter	7-8	2	12	2	6	2		24
	Anhang	9	E-Reihen IEC 60063						

Anmerkungen

76

1 Leistungs-Derating, Kühlung

22



a) aus Afg-Abb. 1.1:

$$\vartheta_{jmax} = 150^\circ\text{C} (P = 0)$$

$$R_{thJA} = \frac{\vartheta_{jmax} - \vartheta_{Knick}}{P_{max}} = \frac{(150 - 25)^\circ\text{C}}{3,5 \text{ W}} = 35,7 \text{ K/W}$$

$$R_{thJC} = \frac{\vartheta_{jmax} - \vartheta_{Knick}}{P_{max}} = \frac{(150 - 25)^\circ\text{C}}{90 \text{ W}} = 1,39 \text{ K/W}$$

- b) – ϑ_{Knick} sinkt ebenfalls um 20 K, also auf 5°C (die Temp.-Differenz $\Delta\vartheta = \Delta T$ bleibt bei 125 K, was einer Parallelverschiebung des das Derating darstellenden Geradenabschnitts entspricht und durch das Intervall $[\vartheta_{Knick}; \vartheta_{jmax} \text{ bzw. } \vartheta_{jzul}]$ definiert ist)
- Die Wärmewiderstände ändern sich *nicht*

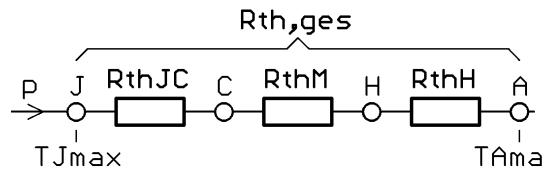
– weiter auf dem nächsten Blatt –

1 Leistungs-Derating, Kühlung (fortgesetzt)

c) vorgeg.: $R_{\text{thJA}} = 35 \text{ K/W}$; geg.: $\vartheta_{A\max} = 60^\circ\text{C}$

$$P_{\text{zul}} = \frac{\vartheta_{J\max} - \vartheta_{A\max}}{R_{\text{thJA}}} = \frac{(130 - 60)\text{K}}{35 \text{ K/W}} = 2 \text{ W}$$

d)



Lsg-Abb. 1.2

e) vorgeg.: $R_{\text{thJC}} = 1,4 \text{ K/W}$; geg.: $\vartheta_{A\max} = 60^\circ\text{C}$

$$R_{\text{th,ges}} = \frac{\vartheta_{J\max} - \vartheta_{A\max}}{P_{\text{zul}}} = \frac{(130 - 60)\text{K}}{25 \text{ W}} = 2,8 \text{ K/W}$$

$$R_{\text{th,ges}} = R_{\text{thJC}} + R_{\text{thM}} + R_{\text{thH}}$$

$$R_{\text{thH}} = R_{\text{th,ges}} - R_{\text{thJC}} - R_{\text{thM}}$$

$$R_{\text{thH}} = (2,8 - 1,4 - 0,2) \text{ K/W} = 1,2 \text{ K/W}$$

abgelesen aus Afg-Abb. 1.1: $\underline{\underline{l_1 = 100 \text{ mm}}}$

f) abgelesen aus Afg-Abb. 1.3: $\underline{\underline{a = 0,4}}$

vorgeg.: $\underline{\underline{R_{\text{thH}}(0) = 1,3 \text{ K/W}}}$

$$a = \frac{R_{\text{thH}}(v)}{R_{\text{thH}}(0)} \rightarrow$$

$$R_{\text{thH}}(v) = a \cdot R_{\text{thH}}(0) = 0,4 \cdot 1,3 \text{ K/W} = 0,52 \text{ K/W}$$

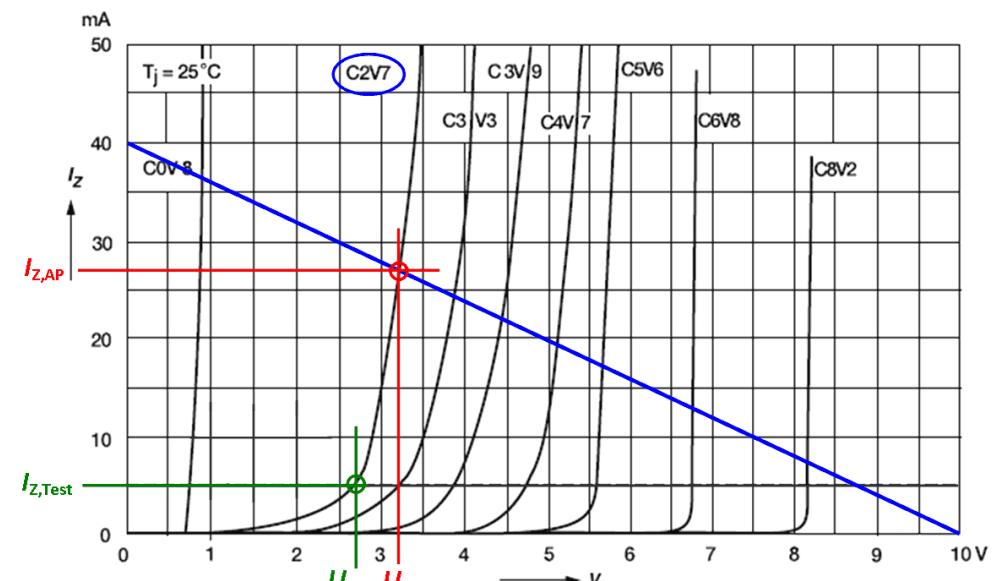
$$R_{\text{th,ges}} = R_{\text{thJC}} + R_{\text{thM}} + R_{\text{thH}}(v) = (1,4 + 0,2 + 0,52) \text{ K/W}$$

$$\underline{\underline{R_{\text{th,ges}} = 2,12 \text{ K/W}}}$$

$$P_{\text{zul}} = \frac{\vartheta_{J\max} - \vartheta_{A\max}}{R_{\text{th,ges}}} = \frac{(130 - 60)\text{K}}{2,12 \text{ K/W}} = 33 \text{ W}$$

2

2 Z-Diode

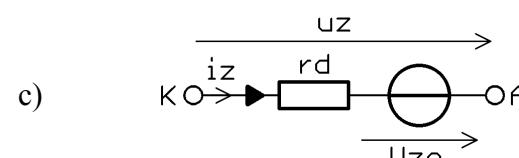


Lsg-Abb. 2.1

a) aus Afg-Abb. 2.1: $\underline{\underline{I_{Z,Test} = 5 \text{ mA}}}$ ($U_Z = U_{Z0} = 2,7 \text{ V}$)

b) $U_Z | I_Z=0 = U_0 = 10 \text{ V}; I_Z | U_Z=0 = \frac{U_0}{R_V} = \frac{10 \text{ V}}{250 \Omega} = 40 \text{ mA}$

s. Lsg-Abb. 3.1: $\underline{\underline{AP = (3,2 \text{ V} | 27 \text{ mA})}}$



Lsg-Abb. 2.2

2

6

4

– weiter auf dem nächsten Blatt –

2 Z-Diode (fortgesetzt)

$$d) \underline{R_D} = \frac{U_{Z,AP}}{I_{Z,AP}} = \frac{5,25 \text{ V}}{35 \text{ mA}} = \underline{150,0 \Omega}$$

$$\underline{r_d} = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z} = \frac{U_{Z,AP} - U_{Z,Nenn}}{I_{Z,AP} - 0} = \frac{(5,25 - 4,7) \text{ V}}{35 \text{ mA}} = \underline{15,71 \Omega}$$

$$P_{ZD} = I_{Z,AP}^2 \cdot R_D + \frac{\hat{I}^2}{2} \cdot r_d$$

$$P_{ZD} = (35 \text{ mA})^2 \cdot 150,0 \Omega + \frac{(10 \text{ mA})^2}{2} \cdot 15,71 \Omega$$

$$\underline{\underline{P_{ZD}}} = \underbrace{183,8 \text{ mW}}_{\text{AP}} + \underbrace{0,7855 \text{ mW}}_{\text{Aussteuerung}} = \underline{\underline{184,5 \text{ mW}}}$$

$$P_{RV} = \left[I_{Z,AP}^2 + \frac{\hat{I}^2}{2} \right] \cdot RV = \left[(35 \text{ mA})^2 + \frac{(10 \text{ mA})^2}{2} \right] \cdot 680 \Omega$$

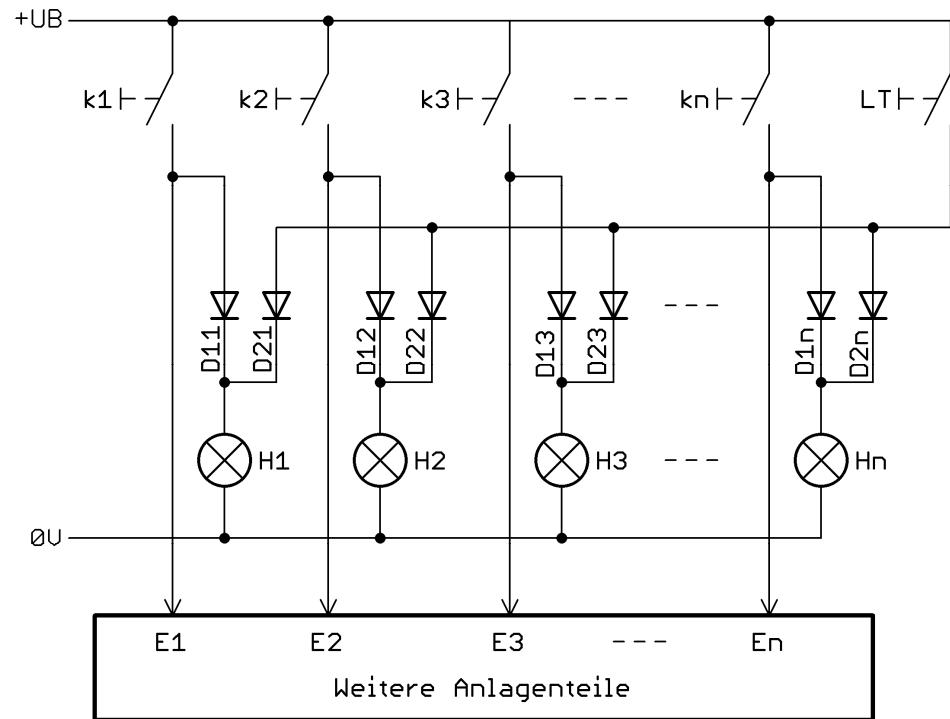
$I_{\text{eff,ges}}^2$

$$\underline{\underline{P_{RV}}} = \underbrace{833,0 \text{ mW}}_{\text{AP}} + \underbrace{34,00 \text{ mW}}_{\text{Aussteuerung}} = \underline{\underline{867,0 \text{ mW}}}$$

10

3 Dioden: Anwendung

8



Lsg-Abb. 3

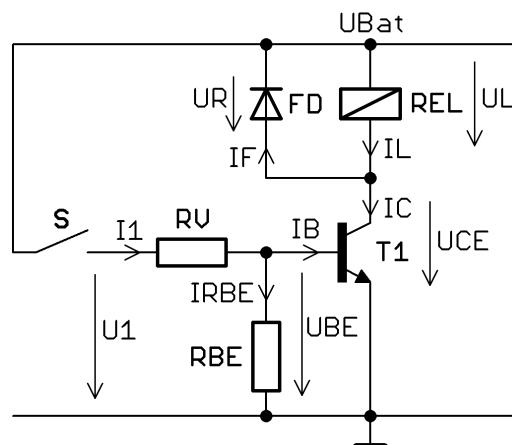
(Dioden $\mathbf{D2}_i$ realisieren die eigentliche Lampentest-Funktion; sie entkoppeln die Leuchtmelder H_i untereinander.

Dioden $\mathbf{D1}_i$ stellen die Rückwirkungsfreiheit zu den weiteren Anlagenteilen (E_i) her.

$\mathbf{D1}_i$ und $\mathbf{D2}_i$ bilden somit jeweils eine rückwirkungsfreie ODER-Funktion:
 $H_i = k_i \vee LT; E_i = k_i$.)

4 BJT als Schalter

24



Lsg-Abb. 4

a) Basis-Emitter-Ableitwiderstand RBE, s. Lsg-Abb. 4.

2

b) U_{CEsat} vernachlässigt $\rightarrow U_{CEsat} = 0$

12

Last (T1 leitet)

Relais REL: 12 V / 3,3 W \rightarrow

$$I_L = \underline{I_C} = P_{REL} / U_{REL} = 3,3 \text{ W} / 12 \text{ V} = 275 \text{ mA}$$

aus Afg-Tab. 4 mit T1 = ... -25 (Current Group) u. dem nächstgelegenen Wert für $I_C = 300 \text{ mA}$: $B_{min} = 100$ RBE (T1 sperrt; $I_1 = 0$; $I_{CB0} = I_{RBE}$ in Lsg-Abb. 4)

I_{CB0} : maßgebend ist $\vartheta_{a,max}$; aus Afg-Abb. 4.2 liest man ab (Kurve „Maximum“): $I_{CB0,max} = 500 \text{ nA}$

$$\text{Si-Transistor: } \underline{\underline{RBE_{max}}} = \frac{0,2 \text{ V}}{I_{CB0,max}} = \frac{0,2 \text{ V}}{500 \text{ nA}} = 400 \text{ k}\Omega$$

$$\underline{\underline{RBE_{E24}}} = 360 \text{ k}\Omega;$$

Probe obere Tolerangrenze: $1,05 \cdot 360 \text{ k}\Omega = 387 \text{ k}\Omega < 400 \text{ k}\Omega$

4 BJT als Schalter (fortgesetzt)

RV (T1 leitet)

$$\underline{\underline{I_B^*}} = \frac{I_C}{B_{min}} = \frac{275 \text{ mA}}{100} = 2,75 \text{ mA};$$

$$\underline{\underline{I_B}} = m \cdot I_B^* = 2,5 \cdot 2,75 \text{ mA} = 6,88 \text{ mA}$$

$$\underline{\underline{I_{RBE}}} = \frac{U_{BEon}}{RBE_{E24}} = \frac{1 \text{ V}}{360 \text{ k}\Omega} = 2,78 \mu\text{A} \ll I_B \rightarrow \underline{\underline{I_1}} \approx \underline{\underline{I_B}}$$

$$\underline{\underline{RV}} = \frac{U_{Bat} - U_{BEon}}{I_1} = \frac{(12-1) \text{ V}}{6,88 \text{ mA}} = 1,60 \text{ k}\Omega \quad (\text{mit } U_{Bat} = U_1)$$

$$\underline{\underline{RV_{E24}}} = 1,60 \text{ k}\Omega$$

c) REL: ohmsch-induktive Last \rightarrow beim Ausschalten (Gegeninduktionsspannung)

2

d) – s. Lsg-Abb. 4

6

- $\underline{\underline{I_{FM}}} = \underline{\underline{I_L}} = \underline{\underline{I_C}} = 275 \text{ mA}; \underline{\underline{U_{RM}}} = \underline{\underline{U_{Bat}}} = 12 \text{ V}$
(in der Praxis Sicherheitszuschläge)

- „Einschalten“ von FD: Spannungsüberhöhung $u_F(0+) \approx 2,5 \text{ V}$
 $u_{CEmax} = u_{CE}(0+) \approx U_{Bat} + u_F(0+) = (12 + 2,5) \text{ V} = 14,5 \text{ V}$

e) Wesentliche Verlängerung der Abfallzeit von REL

2